

無電解Au・Pdめっき

～技術確立と事業化のご案内～



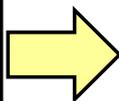
1、技術要旨

電解めっき特有のデメリットに対し、無電解の貴金属めっきのニーズが高まっております。
電解Auめっきを多く取り扱う弊社では、ニーズにお応えすべく無電解Au・Pdめっき工法を確立いたしました。
2015年春に半導体分野を手始めに事業化し、これから幅広く展開して参ります。

2、電解めっきのデメリットは、無電解で

(電解めっき)

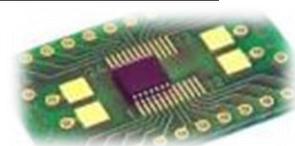
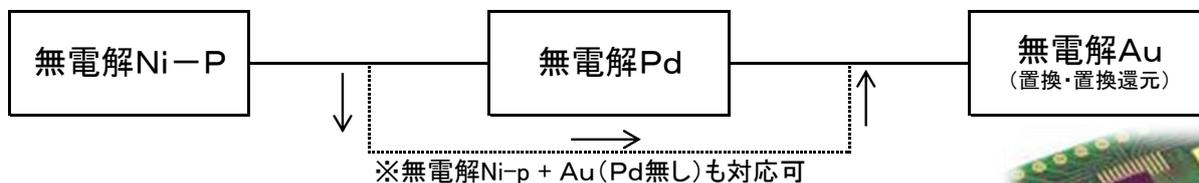
- ・ 通電用の接点エリアの設定が必要
- ・ 接点個所が未着になる
- ・ 導通が必要(不要個所にめっきが必要)
- ・ 膜厚がばらつく(材料費UP・性能不安定)
- ・ 通電確保のために、ダミーが必要



(無電解めっき)

- ・ 接点不要
- ・ 接点確保による未着無し
- ・ 導通不要(金属部分のみめっき析出)
- ・ 膜厚が均一(性能が安定化)
- ・ ダミー不要(材料費削減)

3、めっき仕様



4、特長と膜厚

無電解Ni-P	無電解Pd	無電解Au
膜厚: $0.5 \sim 10 \mu + \alpha$ 鉛フリータイプ	膜厚: $0.05 \sim 0.4 \mu$ 耐熱による下地Ni層の 拡散防止(バリア層)に	膜厚: $\sim 0.1 \mu$ (置換Au) 膜厚: $0.1 \sim 0.5 \mu$ (置換還元Au) WB性・はんだ接合性が良好 ※半導体部品に適したAuめっきです

5、対象物

製品事例	対象物の材質	PR
各種基板 / ガラスハーメ品 接点部品 / 複合部品 など	Cu系 / Fe系 / SUS系 アルミ / Mo / W / Ti メタライズ品(スパッタ・ロウ付け品等)	弊社固有のめっき技術で、アルミ・SUS・ 難素材(Mo・W等)を下地めっきすることが 可能です

(製品イメージ)



～ 不可能への挑戦 ～

株式会社 友電舎

大阪市此花区常吉2-4-8

tel 06-6465-1663

e-mail : info@ydn.co.jp

URL: http://www.ydn.co.jp

